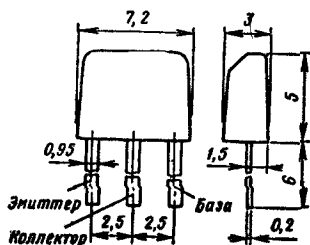


# КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р

КТ315 (А-Р)



Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры  $n-p-n$  усилительные. Предназначены для применения в усилителях высокой, промежуточной и низкой частоты. Выпускаются в пластмассовом корпусе с гибкими выводами. Тип прибора указывается в этикетке, а также на корпусе прибора в виде буквы соответствующего типонаминала.

Масса транзистора не более 0,18 г.

### Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при

$U_{кв} = 10$  В,  $I_k = 1$  мА:

КТ315А, КТ315В	30-120
КТ315Б, КТ315Г, КТ315Е	50-350
КТ315Д	20-90
КТ315Ж	30-250
КТ315И, не менее	30
КТ315Р	150-350

Граничная частота коэффициента передачи тока при

$U_{кв} = 10$  В,  $I_k = 1$  мА, не менее

Устойчивая времени цепи обратной связи при  $U_{кв} = 10$  В

$I_b = 5$  мА, не более:

250 МГц

КТ315А	300 пс
КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	500 пс
КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж	1000 пс
КТ315И	950 пс

Граничное напряжение при  $I_b = 5$  мА, не менее:

КТ315А, КТ315Б, КТ315Ж	15 В
КТ315В, КТ315Д, КТ315И	30 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р	25 В

Напряжение насыщения коллектор — эмиттер при  $I_k = 20$  мА,  $I_b = 2$  мА, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	0,4 В
КТ315Д, КТ315Е	0,6 В
КТ315Ж	0,5 В
КТ315И	0,9 В

Напряжение насыщения база — эмиттер при  $I_k = 20$  мА,  $I_b = 2$  мА, не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Р	1 В
КТ315Д, КТ315Е	1,1 В
КТ315Ж	0,9 В
КТ315И	1,3 В

Обратный ток коллектора при  $U_{кв} = 10$  В, не более

Обратный ток коллектор — эмиттер при  $R_{э} = 10$  кОм,

$U_{кв} = U_{кв. макс.}$ , не более:

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р	1 мкА
КТ315Ж	10 мкА
КТ315И	100 мкА

Обратный ток эмиттера при  $U_{ЭВ} = 5$  В для КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Ж, КТ315И, КТ315Р, не более  
 Входное сопротивление при  $U_{КВ} = 10$  В,  $I_K = 1$  мА, не менее  
 Выходная проводимость при  $U_{КВ} = 10$  В,  $I_K = 1$  мА, не более  
 Емкость коллекторного перехода при  $U_{КВ} = 10$  В, не более  
 КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р  
 КТ315Ж, КТ315И

50 мкА  
 40 Ом  
 0,3 мксм  
 7 пФ  
 10 пФ

### Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор — эмиттер при  $R_{св} = 10$  кОм

КТ315А	25 В
КТ315Б, КТ315Ж	20 В
КТ315В, КТ315Д	40 В
КТ315Г, КТ315Е, КТ315Р	35 В
КТ315И	60 В

Постоянное напряжение база — эмиттер

6 В

Постоянный ток коллектора

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р	100 мА
КТ315Ж, КТ315И	50 мА

Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при  $T \leq +25$  °С

КТ315А, КТ315Б, КТ315В, КТ315Г, КТ315Д, КТ315Е, КТ315Р	150 мВт
КТ315Ж, КТ315И	100 мВт

Тепловое сопротивление переход — среда

0,67 °С/мВт

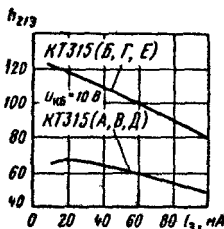
Температура р-п перехода

+120 °С

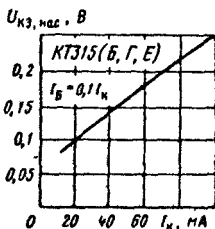
Температура окружающей среды

-60 +100 °С

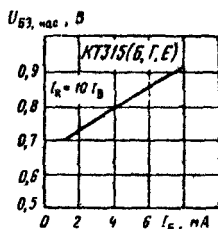
Допускается эксплуатация транзисторов в режиме  $P_K = 250$  мВт при  $U_{КВ} = 12,5$  В,  $I_K = 20$  мА



Зависимости статического коэффициента передачи тока от тока эмиттера



Зависимость напряжения насыщения коллектор — эмиттер от тока коллектора



Зависимость напряжения насыщения база — эмиттер от тока базы